

Физика и техника полупроводников, 2021, том 55, выпуск 8

XXV Международный симпозиум "Нанозфизика и нанозлектроника", Нижний Новгород, 9-12 марта 2021 г.

Илькв И.В., Котляр К.П., Кирилкно Д.А., Осипов А.В., Сошников И.П., Терпицкий А.Н., Цырлин Г.Э.

XXV Международный симпозиум Нанозфизика и нанозлектроника", Нижний Новгород, 9-12 марта 2021 г. Формирование гексагональной фазы германия на поверхности нитевидных нанокристаллов AlGaAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии

621

Кавеев А.К., Бондаренко Д.Н., Терещенко О.Е.

Структурные свойства тонких пленок кристаллического топологического изолятора $Pb_{0.7}Sn_{0.3}Te$ на Si(111)

625

Винниченко М.Я., Махов И.С., Харин Н.Ю., Граф С.В., Паневин В.Ю., Седова И.В., Сорокин С.В., Фирсов Д.А.

Фотопроводимость и поглощение инфракрасного излучения в квантовых ямах p-GaAs/AlGaAs

629

Данилов Ю.А., Алафердов А.В., Вихрова О.В., Здоровейцев Д.А., Ковальский В.А., Крюков Р.Н., Кузнецов Ю.М., Лесников В.П., Нежданов А.В., Дроздов М.Н.

Легирование углеродных нанослоев, выращенных импульсным лазерным методом

637

Дементьев П.А., Дементьева Е.В., Львова Т.В., Берковиц В.Л., Лебедев М.В.

Оптические и электронные свойства пассивированных поверхностей InP(001)

644

Моисеенко И.М., Попов В.В., Фатеев Д.В.

Усиление терагерцовых электромагнитных волн в структуре с двумя слоями графена при протекании постоянного электрического тока: гидродинамическое приближение

649

Ежевский А.А., Гусейнов Д.В., Сухоруков А.В., Калинина Е.А., Новиков А.В., Юрасов Д.В., Гусев Н.С.

Генерация спиновых токов в n-Si, легированном фосфором, сурьмой и висмутом и влияние на них процессов рассеяния спинов с переворотом

654

Гинзбург Н.С., Сергеев А.С., Кочаровская Е.Р., Малкин А.М., Заславский В.Ю.

Повышение мощности и улучшение направленности излучения широкоапертурных гетеролазеров при оптимизации размеров брэгговской решетки

659

Продолжение публикации материалов Симпозиума см. в No 9

Электронные свойства полупроводников

Гудавасов Ш.К., Абдуллаев Н.А., Джалилли Д.Н., Бадалова З.И., Мамедова И.А., Немов С.А.

Эллипсометрические исследования монокристаллов Bi_2Se_3 и $Bi_2Se_3<Cu>$

665

Боднарь И.В., Фещенко А.А., Хорошко В.В., Павловский В.Н., Свитенков И.Е., Яблонский Г.П.

Температурная зависимость ширины запрещенной зоны монокристаллов $AgIn_8S_{12.5}$

669

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Велиев Р.Г., Абдуллаев Н.А., Амирасланов И.Р., Мамедова И.А., Мамедов Д.А., Бадалова З.И., Гудавасов Ш.К., Немов С.А.

Оптические фононы в полупроводниковых соединениях $TiFeS_2$, $TiFeSe_2$

673

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Talla J.A., Almahmoud E.A., Abu-Farsakh H.

Rippling Effect on the Electrical Properties of Boron Nitride Monolayer: Density Functional Theory

679

Raidou A.

Effect of Complexing Agents on Structural, Morphological, and Optical Properties of Chemically Deposited ZnO Thin Films

680

- Atoui M., Benzeghda S., Touam T., Chelouche A., Djouadi D.
Ag Doping Effects on the Microstructure, Morphology, Optical, and Luminescence Properties of Sol-Gel-Deposited ZnO Thin Films 681
- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**
 Семакова А.А., Смирнов А.М., Баженов Н.Л., Мынбаев К.Д., Пивоварова А.А., Черняев А.В., Кижаяев С.С., Стоянов Н.Д.
Спектральные и электрические свойства светодиодных гетероструктур с активной областью на основе InAs 682
- Moskalenko S.A., Moskalenko V.A., Podlesny I.V., Liberman M.A.
Two-Dimensional Electron.Hole System under the Influence of the Chern--Simons Gauge Field Created by the Quantum Point Vortices 688
- Физика полупроводниковых приборов**
 Алексеев Р.П., Черных М.И., Цоцорин А.Н., Семейкин И.В., Быкадорова Г.В.
Подавление эффекта квазинасыщения вольт-амперных характеристик мощных сверхвысокочастотных латеральных транзисторов 689
- Верхолетов М.Г., Прудаев И.А.
Влияние барьерных контактов на транспорт носителей заряда в однородных структурах из GaAs, легированных глубокими центрами Cr и EL2 693
- Малевская А.В., Калюжный Н.А., Малевский Д.А., Минтаиров С.А., Надточий А.М., Нахимович М.В., Солдатенков Ф.Ю., Шварц М.З., Андреев В.М.
Инфракрасные (850 нм) светодиоды с множественными квантовыми ямами InGaAs и "тыльным" отражателем 699
- Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**
 Середин П.В., Барков К.А., Голощапов Д.Л., Леньшин А.С., Худяков Ю.Ю., Арсентьев И.Н., Лебедев А.А., Шарофидинов Ш.Ш., Мизеров А.М., Касаткин И.А., Prutskij Tatiana
Влияние предобработки подложки кремния на свойства пленок GaN, выращенных методом хлорид-гидридной газофазной эпитаксии 704